

平成 27 年 6 月 30 日

委 員 各 位

日本学術振興会ワイドギャップ半導体
光・電子デバイス第 162 委員会
委員長 吉川 明彦

日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会
第 90 回委員総会・第 94 回研究会 開催案内

日時：平成 27 年 7 月 24 日（金）

委員総会： 12:00 - 13:00

研究会： 13:00 - 17:15

場所：主婦会館プラザエフ（JR「四ツ谷駅」麴町口より徒歩1分）

委員総会／研究会：クラルテ

〒102-008 東京都千代田区六番町 15

TEL: 03-3265-8111、URL : <http://plaza-f.or.jp/index2/>

委員総会

議 題：

- (1) 前回第 89 回委員総会 議事要録について
- (2) 委員の異動について
- (3) H26 年度収支決算について
- (4) H27 年度予算案について
- (5) 次回第 95 回研究会以降の研究会について
- (6) その他

報告事項：

- (1) 学振担当者の交代
- (2) 開催報告：ノーベル物理学賞レクチャー、祝賀会（4/20 開催：東京医科歯科大学）
- (3) （協賛会議の報告）ISPlasma2015、LEDIA15、第 7 回窒化物半導体結晶成長講演会、EMS-34
- (4) （協賛会議の案内）第 141 委員会主催国際シンポジウム(ALC' 15)
- (5) （賛同書）エコトピア科学研究所研究拠点申請について（名大・財満先生）
- (6) その他

研究会 主 題：「窒化物半導体基板の進展と今後の展望」

「委員長挨拶・企画趣旨説明」（13:00-13:05）

1. 「窒化物半導体用各種基板と III 族窒化物半導体のヘテロ成長」（13:05 - 13:50）

松岡 隆志 東北大学 金属材料研究所

2. 「酸性アモノサーマル法によるバルク GaN 結晶成長」 (13 : 50 - 14 : 35)

三川 豊 三菱化学 株式会社

休憩 (14:35-15:00)

3. 「Na フラックス・ポイントシード法、及び OVPE 法による GaN バルク結晶育成」 (15 : 00 - 15 : 45)

森 勇介, 今出 完, 丸山 美帆子, 吉村 政志 大阪大学

4. 「HVPE 法による GaN 非極性基板作製」 (15 : 45 - 16 : 30)

只友 一行, 岡田 成仁, 山根 啓輔* 山口大学, *豊橋技術科学大学

5. 「窒化物半導体結晶成長用基板表面の第一原理計算による考察」 (16 : 30 - 17 : 15)

寒川 義裕 九州大学

<追記>

1. 7月24日の委員総会では、ご出席の回答をいただいた委員・同伴者に昼食をご用意いたします。
2. 当日は、出席名簿にご署名・交通費の要否・空路陸路の種別等のご記入をお願いいたします。
ご記入の無い場合は、学振からのお支払ができませんので、よろしく願いいたします。
3. 準備の都合上、委員総会・研究会の出欠回答を7月13日(月)までに日本学術振興会研究事業課 須賀 様 (jigyouka06@jsps.go.jp) 宛に、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。